

子有限公司 CV4N65C POWER MOSFET

ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

650V N-Channel VDMOS 使用及贮存时需防静电 符合 RoHS 等环保指令要求

#### 1. 主要用途

主要用于 LED驱动、电源适配器 等各类功率开关电路

#### 2. 主要特点

- l 开关速度快
- I 通态电阻小,输入电容小

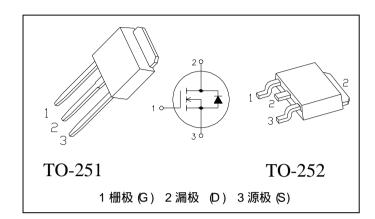
## 3. 封装外形

TO-251/252

#### 4. 电特性

#### 4.1极限值

除非另有规定, T<sub>amb</sub>= 25



参数名称	符号	额定值	单位
漏极-源极电压	$V_{ m DSS}$	650	V
连续漏极电流	$I_{\mathrm{D}}$	4	A
漏极脉冲电流	$I_{DM}$	16	A
栅源电压	$V_{GS}$	± 30	V
单脉冲雪崩能量	$E_{AS}$	128	mJ
热阻 ( 结到壳 )	R <sub>JC</sub>	3.57	/W
耗散功率(Ta=25 )	P <sub>tot</sub>	35	W
结温	$T_{j}$	150	
贮存温度	$T_{stg}$	-55 ~ 150	

#### 4.2 电参数

除非另有规定, Tamb= 25

FINAL / Family 25							
参数名称	符号	河北发州	规 范 值			单位	
		测试条件	最小	典型	最大	半辺	
漏源击穿电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS}$ =0V , $I_D$ =250 $\mu$ A	650			V	
通态电阻	${ m R_{DSON}}^*$	$V_{GS}=10V$ , $I_D=2A$		2	2.5		
阈值电压	V <sub>GS (TH)</sub>	$V_{DS}=V_{GS}$ , $I_{D}=250 \mu A$	2		4	V	
漏源漏电流	$I_{DSS}$	V <sub>DS</sub> =650V , V <sub>GS</sub> =0V			25	μA	
栅源漏电流	$I_{GSS}$	$V_{GS} = \pm 30V$			± 10	μA	
源漏二极管正向压降	${ m V_{SD}}^*$	$I_S=4A$ , $V_{GS}=0V$			1.5	V	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$	$V_{DD}$ =250V , $I_D$ =4A		50		ns	
		$R_G=25$ , $V_{GS}=10V$		50			
输入电容	$C_{iss}$	$V_{GS}$ =0V , $V_{DS}$ =25V		470		ωE	
		f=1.0MHZ	470			pF	
* 脉冲测试:tp 300us, 2%							

\* L=10mH ,  $I_D$ =4A ,  $T_J$ = 25



ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.



POWER MOSFET

#### 4.特性曲线

安全工作区(直流)

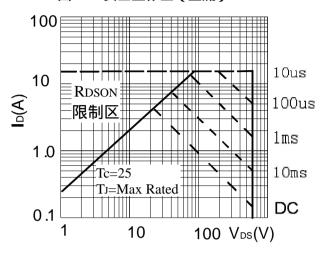
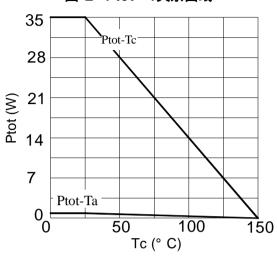
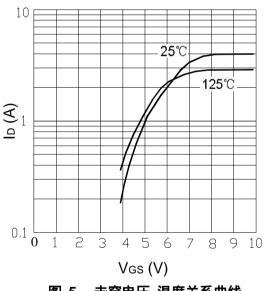


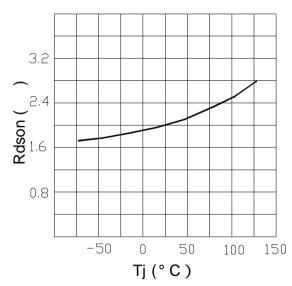
图 2 Ptot-T关系曲线



传输特性曲线 图 3



通态电阻-温度关系曲线



击穿电压 温度关系曲线 图 5

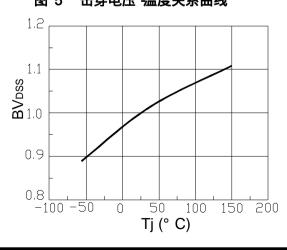
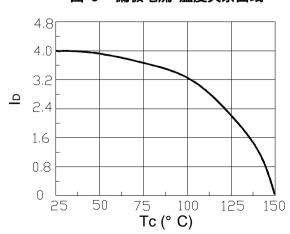


图 6 漏极电流 温度关系曲线



地址:深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园3号厂房 电话:0755-29799516 传真:0755-29799515

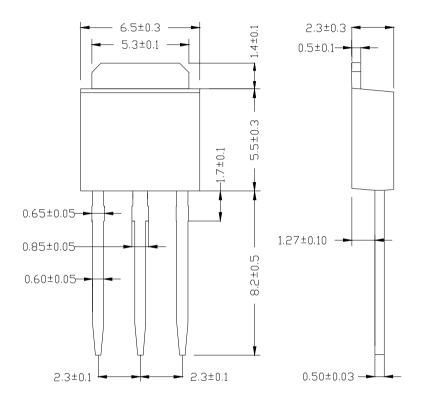




ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

# 6. 产品外形尺寸图 (单位: mm)

#### TO-251



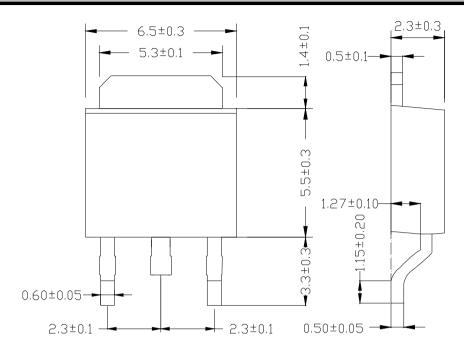
TO-252

地址:深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园3号厂房 电话:0755-29799516 传真:0755-29799515



**GVAN65C** 

ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd. POWER MOSFET



地址:深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 3 号厂房 电话: 0755-29799516 传真: 0755-29799515